# ノート

## 1GHz 超における EMC 対策部品の効果に関する研究

藤原 康平\*1) 近藤 崇\*2) 髙橋 文緒\*2)

Study of the effect of EMC components beyond 1 GHz Kohei Fujiwara<sup>\*1)</sup>, Takashi Kondo<sup>\*2)</sup>, Fumio Takahashi<sup>\*2)</sup>

**キーワード**: EMC 対策部品,チップビーズ,電磁環境適合性 **Keywords**: EMC components, Chip beads, Electromagnetic environment

### 1. はじめに

近年,依頼試験品のノイズ対策に関する技術相談が増加 傾向にある。更に,将来的には電子機器のクロック周波数 の上昇に伴い,1GHz 超を見据えた対策が要求される。

また,平成22年4月からは,多摩テクノプラザの電波暗 室が稼動を開始し,新しい VCCI の規格に準拠した6 GHz までの計測評価が可能となった為,GHz 帯における対策部 品の効果等の定量的評価が必要である。

本研究では、EMC 対策部品の高周波諸特性の測定,電磁 界シミュレータを用いた検証,電波暗室における放射雑音 測定を行い,EMC 対策部品の諸特性およびシミュレーショ ン結果と、EMC 対策部品の放射ノイズに対する効果との相 関を検証する事を目的とする。

## 8. 周波数帯における電波雑音の種類とその対策 方法

周波数帯と EMC 対策方法の関係を表1に示す。1 GHz 以 下の周波数帯では、伝導性と放射性の電波雑音が存在する。 それに対し、1 GHz を超える周波数帯では、放射性の電波雑 音、すなわち筐体内から放射される電磁波が支配的である。

	現状の対策	本研究で行うGHz超の対策
周波数範囲	≦1GHz	1GHz <f<6ghz< td=""></f<6ghz<>
妨害の種類	伝導性 放射性	放射性
対策部品の種類	コンデンサ	フェライトビーズ
	コモンモードチョーク	信号線用フィルタ
	クランプフィルタ	コモンモードフィルタ等
対策効果の例	f<100MHzにおいて約-15dB 程度の効果	GHz帯における対策効果を 検証する。

表1. 周波数と EMC 対策方法

ある周波数帯の放射性の電波雑音を低減させるには、その雑音の周波数帯を減衰させるEMC対策部品を機器へ組み 込む手法があり、そのEMC対策部品としてチップビーズ、

\*1) エレクトロニクスグループ

\*<sup>2)</sup> 電子機械グループ

信号線用フィルタ等が各社から販売されている。

#### 3. EMC 対策部品の諸特性の計測

EMC 対策部品であるチップビーズを選択し、インピーダ ンスと散乱パラメータ(Sパラメータ)を測定し、実測値と メーカ公表値を比較し実力値を把握する。

測定にはインピーダンスアナライザ(Agilent E4991A)を 用い,チップビーズのインピーダンスと順方向反射係数 (S11)と順方向伝達係数(S21)を測定した。図1に300kHz から3 GHzにおけるインピーダンスの測定結果を示す。



図1. 測定したチップビーズのインピーダンス

実測したインピーダンスは 100 MHz において 108 Ωであった。メーカ公表のインピーダンスは 100 MHz において 120  $\Omega \pm 25\%$ である。本測定により、実測したインピーダンスが 公表値の範囲内にある事が確認できた。

測定に用いたインピーダンスアナライザは,測定したインピーダンスを S パラメータへ変換する機能を持つ。図 2 に同周波数帯における S パラメータの測定結果を示す。メーカ公表値を▲,測定値を○でプロットした。その結果, 著者らの測定方法の正しさが確認された。



図 2. チップビーズの S11 と S21 パラメータ

#### 4. 電磁界シミュレータを用いた検証

チップビーズと伝送線路が組み合わされた特性を検証す る為に、チップビーズを搭載した評価基板を作成し、電磁 界シミュレータと実測で差異を検証した。

シミュレーションでは、自由空間中に存在する特性イン ピーダンス 50 Ωのマイクロストリップ基板上にチップビー ズが搭載されているモデルを作成した。

本評価基板はガラスエポキシ基板で作成するので,基板 母材の比誘電率を4.3,金属面は完全導体とした。チップビ ーズのモデルは、インピーダンスアナライザで測定した S パラメータをモデル中に内挿させた。図 3 に試作を行った 評価基板の写真を示す。検証の結果,評価基板の実測値と シミュレーション値が一致する事を確認した。



図 3. 評価基板

#### 5. 放射雑音測定

マイクロストリップライン法 (IEC62333-2) に準ずる方法 で評価基板から放射される信号レベルを3m法電波暗室内 で測定し、チップビーズ単体のS21パラメータと信号レベ ルの相関を比較し効果を検証した。図4に電波暗室におけ るセットアップの様子を示す。

スペクトラムアナライザ (ADVANTEST U3751) のトラッ キングジェネレータを評価基板側に,受信ポートを受信ア ンテナ (BBHA9120E) と接続して,周波数を100 kHzから 3 GHz まで掃引し,評価基板から放射される信号レベルを測 定した。

図5に電磁界シミュレーションで計算した評価基板のS21

パラメータ(▲),試作した評価基板とチップビーズを含め て測定した S21 パラメータ(▼),電波暗室内で測定した信 号レベル(○),およびメーカ公表の S21 パラメータ(□) の相関関係を示す。

この結果から,500 MHz から 1.5 GHz においてチップビー ズのノイズ低減効果と S21 パラメータの間に相関関係が存 在する事を確認した。以上を踏まえ、今後はシグナルイン テグリティとSパラメータの関係性を調査して行きたい。



図4. 電波暗室における実験セットアップ



図 5. 電磁界シミュレーションで計算した評価基板の S21 パラ メータ(▲), 試作した評価基板とチップビーズを含めて測定 した S21 パラメータ(▼), 電波暗室内で測定した信号レベル (○), およびメーカ公表の S21 パラメータ(□)の相関関係

#### 6. まとめ

周波数帯域 500 MHz から 1.5 GHz において,電波暗室内 で測定した信号レベル,メーカ公表の S21 パラメータ,お よび電磁界シミュレータで計算した結果共に相関が確認で きた。この事から,放射ノイズ低減効果が S21 パラメータ の間に存在する事を確認した。

(平成 22 年 6 月 30 日受付, 平成 22 年 8 月 16 日再受付)